

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Februar 2004 (19.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/015754 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/316,
21/321, 21/762, 21/322, 21/32, 21/763

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002523

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. Juli 2003 (26.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 34 694.1 30. Juli 2002 (30.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CHUNG, Hin-Ylu
[DE/DE]; Daimlerstrasse 10, 89160 Dornstadt (DE).
GUTT, Thomas [DE/DE]; Trudering Strasse 2, 82008
Unterhaching (DE).

(74) Anwalt: KARL, Frank; Patentanwälte Kindermann,
Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, SG, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

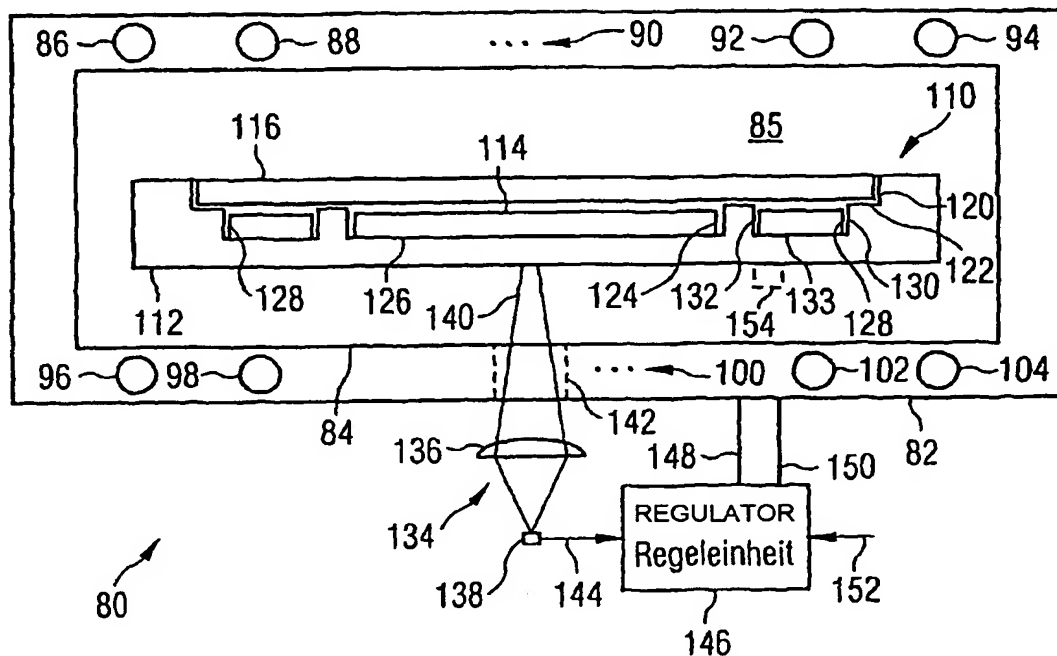
— mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 21. Mai 2004

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OXIDATION OF A LAYER AND CORRESPONDING HOLDER DEVICE FOR A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM OXIDIEREN EINER SCHICHT UND ZUGEHÖRIGE AUFNAHMEVORRICHTUN-
GEN FÜR EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: Amongst other things a method is disclosed, whereby a layer for oxidation is preferably processed in a single sub-
strate process, whereby the process temperature during the processing is recorded directly on the substrate or on a holder device
(110) for the substrate. Oxide layers with precisely fixed oxide widths can be generated.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

In1243TW

Abstract

Method for oxidizing a layer, and associated holding devices for a substrate

The invention explains, inter alia, a method in which a layer which is to be oxidized is processed, preferably in a single-substrate process, the process temperature during the processing being recorded directly at the substrate (114) or at a holding device (110) for the substrate. It is possible to produce oxide layers with an accurately predetermined oxide width.

(Figure 3)